
R32C/100 シリーズ

外部バスの使用例

R01AN0389JJ0101

Rev.1.01

2011.11.30

要旨

本アプリケーションノートでは、R32C/100シリーズの外部バスの使用例について説明します。

対象デバイス

R32C/116グループ

R32C/117グループ

R32C/118グループ

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

目次

1. 仕様.....	3
2. 動作確認条件	4
3. 関連アプリケーションノート	4
4. 周辺機能説明	5
4.1 リードタイミング	6
4.2 ライトタイミング	9
4.3 EBC0~EBC3の設定値	12
5. ハードウェア説明	12
5.1 使用端子一覧	12
6. ソフトウェア説明	13
6.1 動作概要	13
6.2 定数一覧	14
6.3 フローチャート.....	14
6.3.1 メイン処理.....	14
6.3.2 外部バス初期設定.....	15
7. サンプルコード.....	16
8. 参考ドキュメント	16

1. 仕様

外部デバイス上に書かれたプログラムを動作させる方法を示します。マイコンと外部デバイスはセパレートバス(データバス幅は16bit)で接続します。表 1.1に使用する周辺機能と用途を、図 1.1に接続例を示します。

表 1.1 使用する周辺機能と用途

周辺機能	用途
外部バス	外部デバイスと接続
タイマA(タイマA0)	外部デバイス上に書かれたプログラムで使用

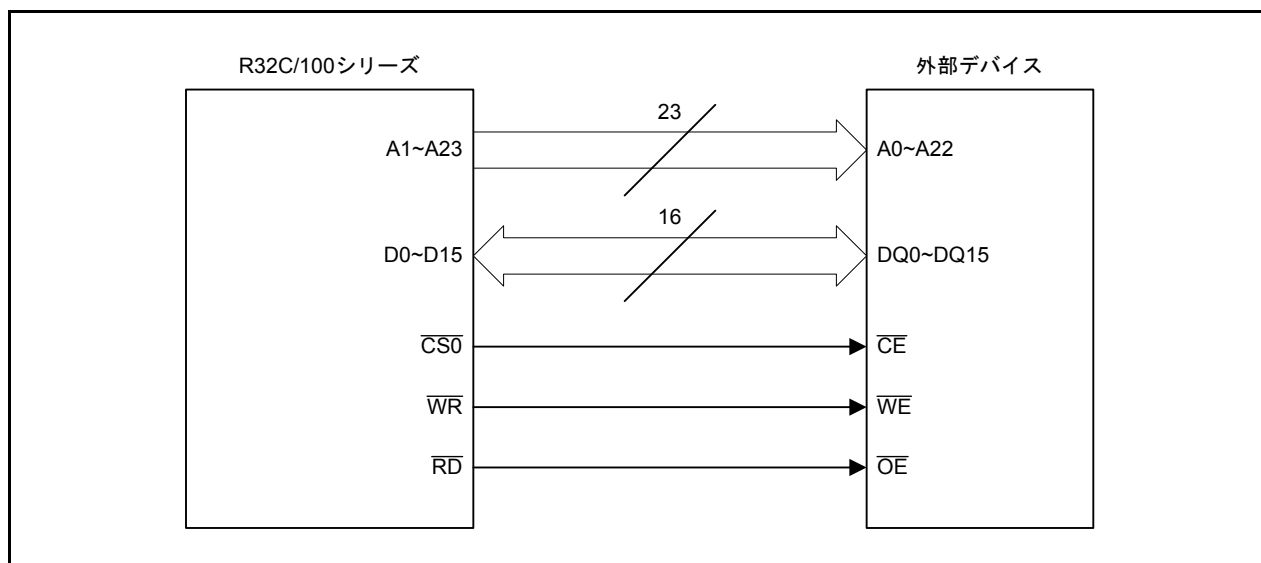


図 1.1 接続例

2. 動作確認条件

本アプリケーションノートのサンプルコードは、下記の条件で動作を確認しています。

表 2.1 動作確認条件

項目	内容
使用マイコン	R5F64189DFD(R32C/118グループ)
動作周波数	<ul style="list-style-type: none"> •メインクロック : 16MHz •PLLクロック : 100MHz •ベースクロック : 50MHz •CPUクロック : 50MHz •周辺バスクロック : 25MHz •周辺機能クロック源 : 25MHz
動作電圧	3.3V
統合開発環境	ルネサス エレクトロニクス製 High-performance Embedded Workshop Version 4.07
Cコンパイラ	ルネサス エレクトロニクス製 R32C/100 Series C Compiler V.1.02 Release 01 コンパイルオプション -D __STACKSIZE__=0X300 -D __ISTACKSIZE__=0X300 -DVECTOR_ADR=0x0FFFFFFBDC -c -finfo -dir "\$(CONFIGDIR)" (統合開発環境のデフォルト設定を使用しています)
動作モード	メモリ拡張モード
サンプルコードのバージョン	Version 1.00
使用デバッガ(注1)	E30Aエミュレータ E30Aエミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
使用ツール	外部フラッシュ定義エディタ (EFE)

注1. E8aでは、本サンプルプログラムをダウンロードすることは出来ません。

3. 関連アプリケーションノート

本アプリケーションノートに関連するアプリケーションノートを以下に示します。併せて参照してください。

- R32C/100シリーズ メインクロック通倍モード設定手順(RJJ05B1259)
- R32C/100シリーズ タイマA動作(タイマモード)(RJJ05B1374)

4. 周辺機能説明

外部バスについて補足します。基本的な内容はユーザーズマニュアルハードウェア編に記載しています。

R32C/100 シリーズでは、外部デバイス (ROM など) を接続するための外部バスがあります。外部デバイスと通信するためのタイミング設定について示します。

外部デバイスおよび R32C/100 シリーズの電気的特性を元に、外部デバイスとのバスタイミングを算出してください。

本アプリケーションノートで使用した外部デバイスのバスタイミングを表 4.1 に示します。詳細はユーザーズマニュアルと外部デバイスのデータシートを参照してください。

表 4.1 外部デバイスパラメータ

記号	項目	値
t_{CE}	チップセレクトアクセス時間	70ns (最大)
t_{OE}	出力イネーブルアクセス時間	25ns (最大)
t_{CS}	チップセレクトセットアップ時間	0ns (最小)
t_{WP}	ライトパルス幅	45ns (最小)

外部バスのタイミング ($t_{su}(A-R)$ 、 $t_w(R)$ 、 $t_{su}(A-W)$ 、 $t_w(W)$) は、ベースクロックとバスサイクル数で決まります。バスサイクル数は EBC0~EBC3 レジスタで設定してください。本アプリケーションノートでは、ベースクロックを 50MHz (1 サイクルあたり 20ns) で算出しています。

4.1 リードタイミング

外部デバイスからリードする場合のバスタイミング算出方法を示します。R32C/100 シリーズのリードサイクルを図 4.1 に示します。

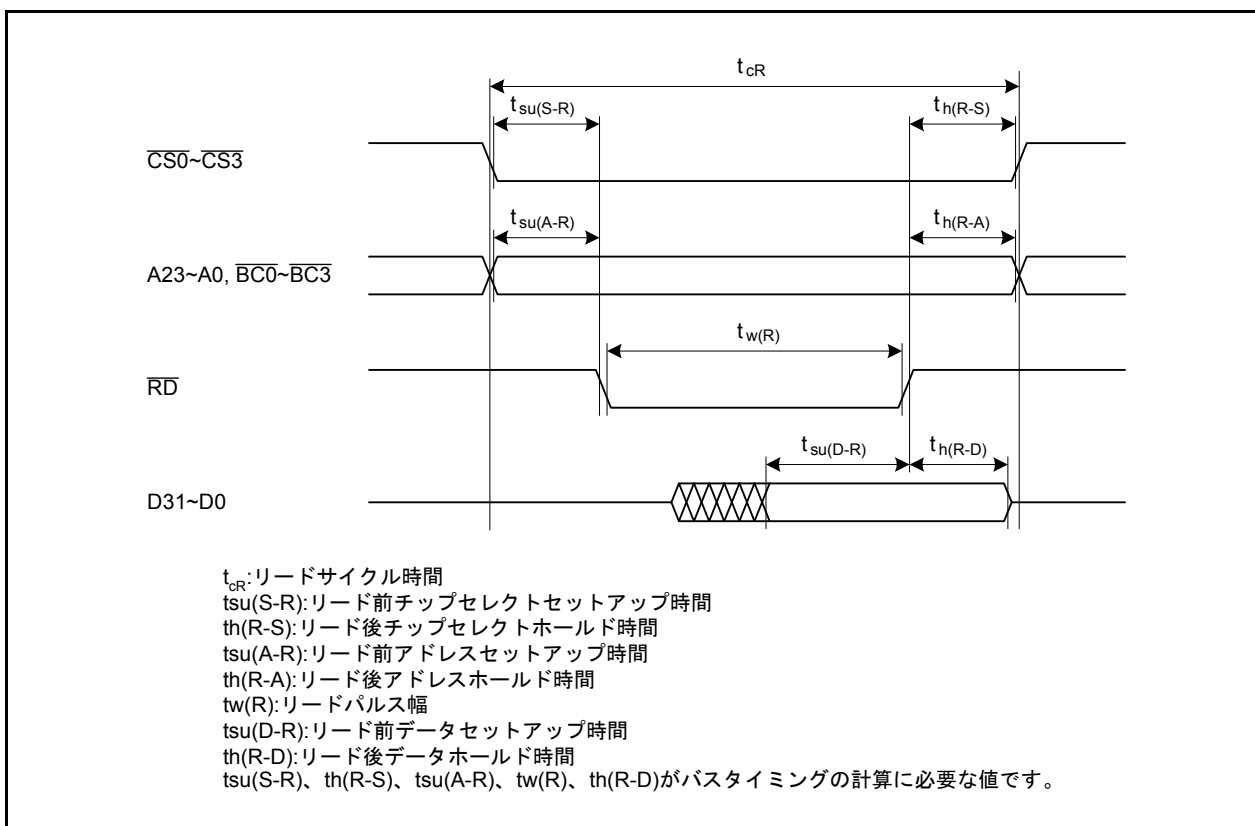


図 4.1 R32C/100 シリーズのリードサイクル

外部デバイスのバスタイミング例を図 4.2 に示します。

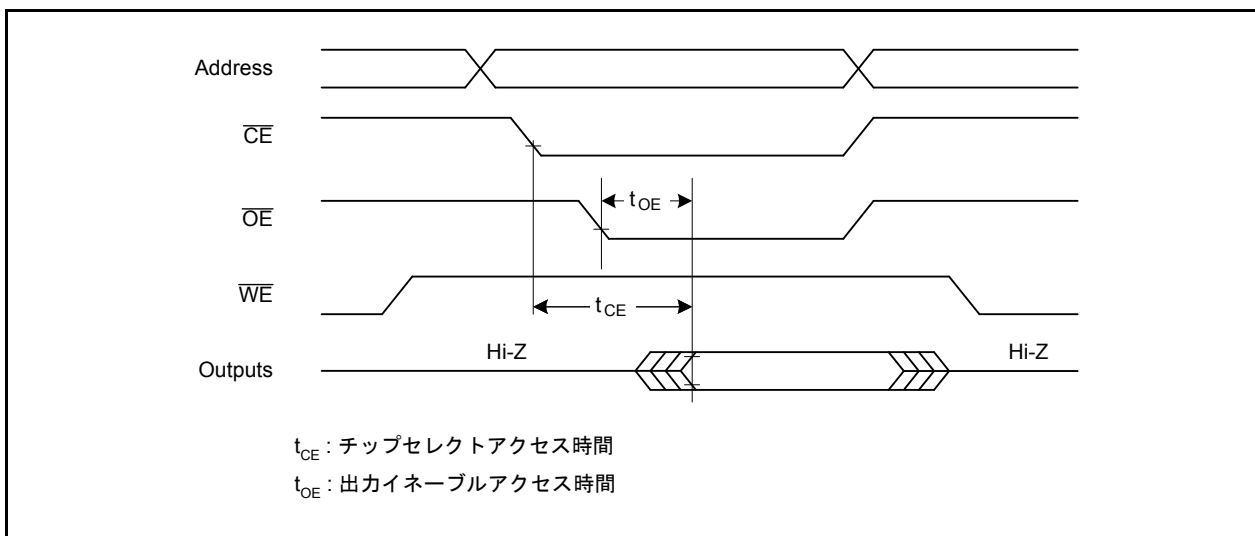


図 4.2 外部デバイスのバスタイミング例（リード時）

外部デバイスの要求タイミグ (t_{CE} と t_{OE}) から、外部バスタイミグの $t_{su}(A-R)$ ($=t_{su}(S-R)$)、 $t_w(R)$ の値を算出します。外部デバイスと外部バスのバスタイミグを比較し、図 4.3 に示します。

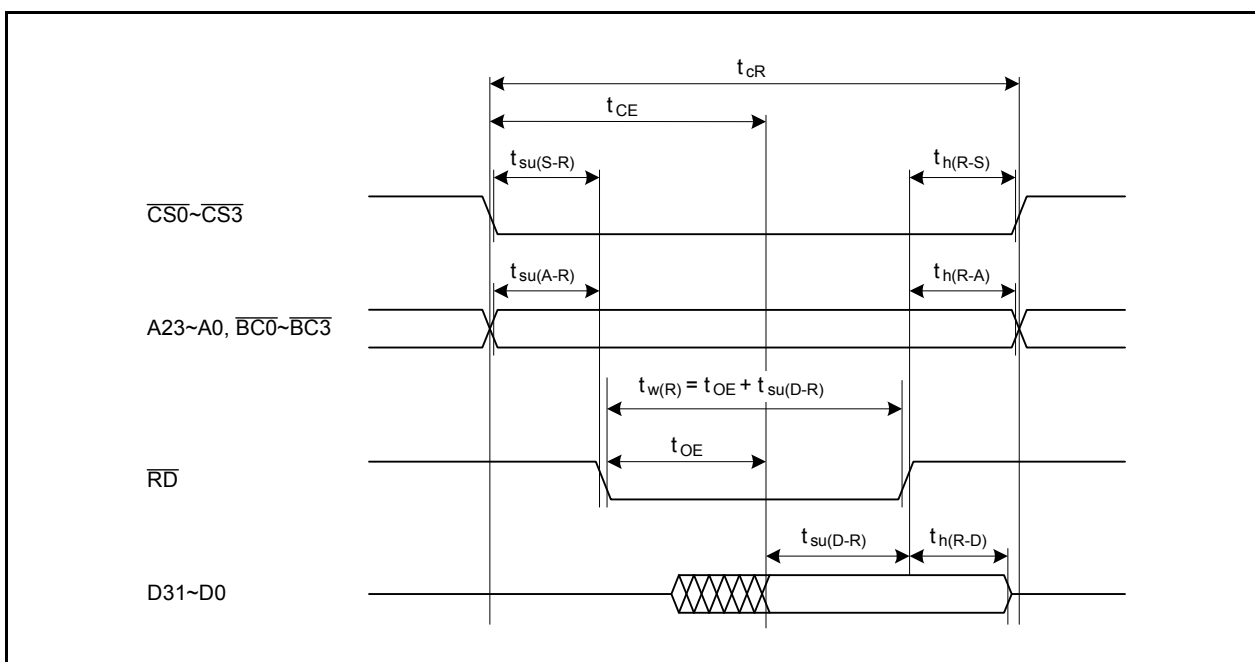


図 4.3 R32C/100 シリーズと外部デバイスのリードバスタイミグ比較図

【リードサイクル時間の算出】

リードサイクル時間は、以下の関係式が成立するように $t_{su}(A-R)$ と $t_w(R)$ を算出します。

$$t_{CE} + t_{su}(D-R) \leq t_{su}(A-R) + t_w(R)$$

表 4.1 から t_{CE} は 70ns、ユーザーズマニュアルから $t_{su}(D-R)$ は 40ns ですので、左辺の式は、

$$70ns + 40ns = 110ns$$

となります。したがって、

$$110ns \leq t_{su}(A-R) + t_w(R)$$

となるように時間を決定します。

$t_w(R)$ は図 4.3 から、 $t_{OE} + t_{su}(D-R)$ 以上となるように時間を調整します。ユーザーズマニュアルから $t_{su}(D-R)$ は 40ns、表 4.1 から t_{OE} は 25ns ですので、 $t_w(R)$ は 65ns 以上の時間を確保します。表 4.2 から $t_w(R)$ の最適値は 80ns になります。

表 4.2 MPY1~MPY0 ビット、EWR1~EWR0 ビットの設定値と $T_w(R)$ ($t_w(R)$) の関係

EWR1~EWR0 ビットの設定値		MPY1~MPY0 ビットの設定値			
		00b	01b	10b	11b
		mpy = 1	mpy = 2	mpy = 3	mpy = 4
00b	wr = 1	1.5 (20ns)	2.5 (40ns)	3.5 (60ns)	4.5 (80ns)
01b	wr = 2	2.5 (40ns)	4.5 (80ns)	6.5 (120ns)	8.5 (160ns)
10b	wr = 3	3.5 (60ns)	6.5 (120ns)	9.5 (180ns)	12.5 (240ns)
11b	wr = 4	4.5 (80ns)	8.5 (160ns)	12.5 (240ns)	16.5 (320ns)
計算式		$T_w(R) = wr \times mpy + 0.5$			

注1. 表の網掛け部分は条件を満たしていない項目です。

注2. 単位はサイクルです。

算出した $t_w(R)$ の値を前述の式に当てはめると、

$$110ns \leq t_{su}(A-R) + 80ns$$

となります。したがって、 $t_{su}(A-R)$ は 30ns 以上の時間を確保します。表 4.3 から $t_{su}(A-R)$ の最適値は 35ns になります。

表 4.3 MPY1~MPY0 ビット、ESUR1~ESUR0 ビットの設定値と $T_{su}(A-R)$ ($t_{su}(A-R)$) の関係

ESUR1~ESUR0 ビットの設定値		MPY1~MPY0 ビットの設定値			
		00b	01b	10b	11b
		mpy = 1	mpy = 2	mpy = 3	mpy = 4
00b	sur = 0	0.5 (-5ns)	0.5 (-5ns)	0.5 (-5ns)	0.5 (-5ns)
01b	sur = 1	1.5 (15ns)	2.5 (35ns)	3.5 (55ns)	4.5 (75ns)
10b	sur = 2	2.5 (35ns)	4.5 (75ns)	6.5 (115ns)	8.5 (155ns)
11b	sur = 3	3.5 (55ns)	6.5 (115ns)	9.5 (175ns)	12.5 (235ns)
計算式		$T_{su}(A-R) = sur \times mpy + 0.5$			

注1. 表の網掛け部分は条件を満たしていない項目です。

注2. 単位はサイクルです。

$t_w(R)$ と $t_{su}(A-R)$ の時間に該当する mpy、sur、wr の設定値を表 4.2、表 4.3 から取得します。

表 4.4 mpy、sur、wr 設定値

mpy	sur	wr
1	2	4
2	1	2
3	該当する値はなし	該当する値はなし
4	該当する値はなし	1

4.2 ライトタイミング

外部デバイスにライトする場合のバスタイミング算出方法を示します。R32C/100 シリーズのライトサイクルを図 4.4 に示します。

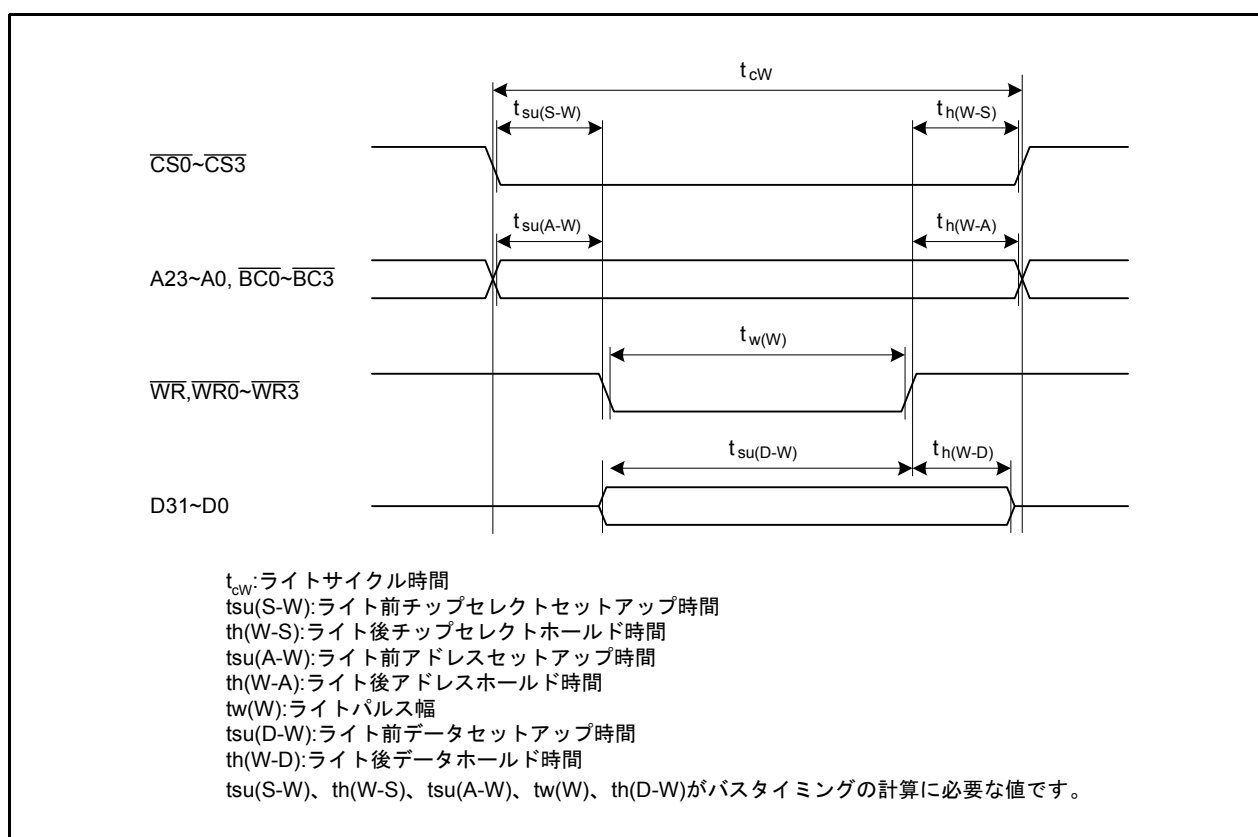


図 4.4 R32C/100 シリーズのライトサイクル

外部デバイスのバスタイミング例を図 4.5 に示します。

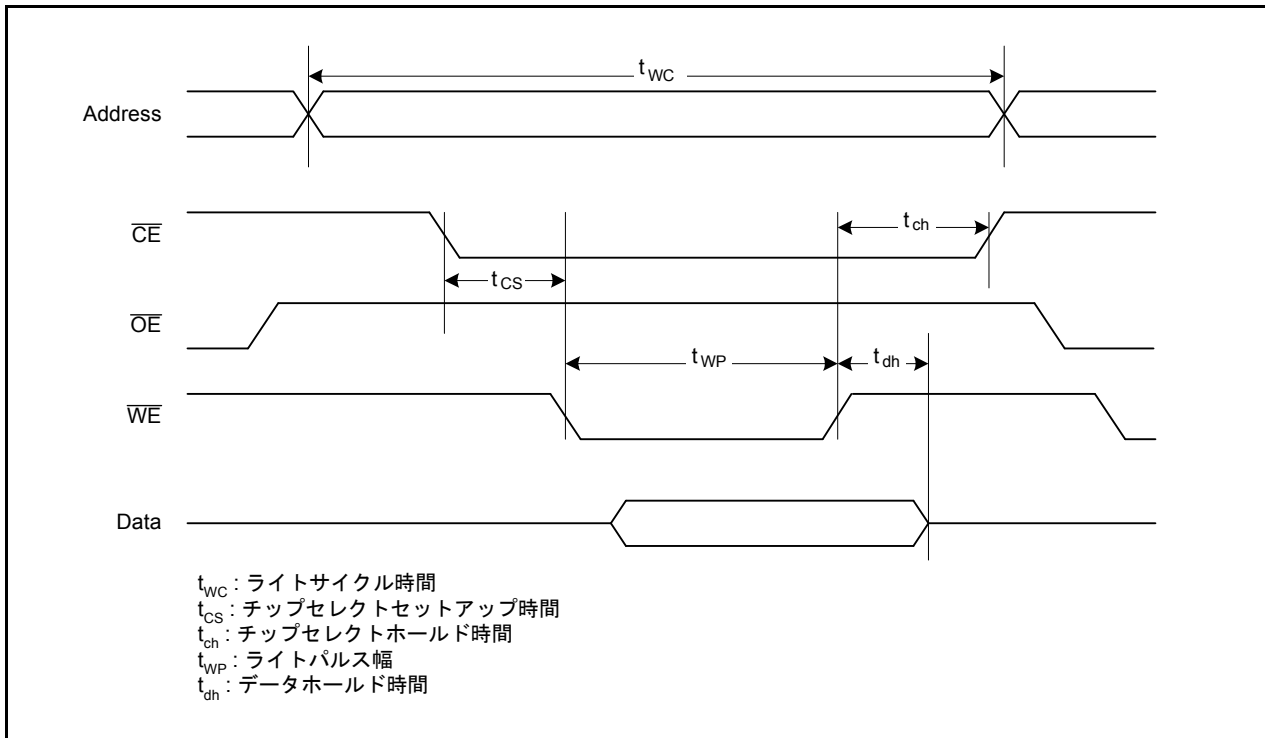


図 4.5 外部デバイスのバスタイミング例(ライト時)

外部デバイスの要求タイミング(t_{CS} と t_{WP})から、外部バスタイミングの $t_{su(A-W)} (=t_{su(S-W)})$ 、 $t_w(W)$ の値を算出します。外部デバイスと外部バスのバスタイミングを比較し、図 4.6 に示します。

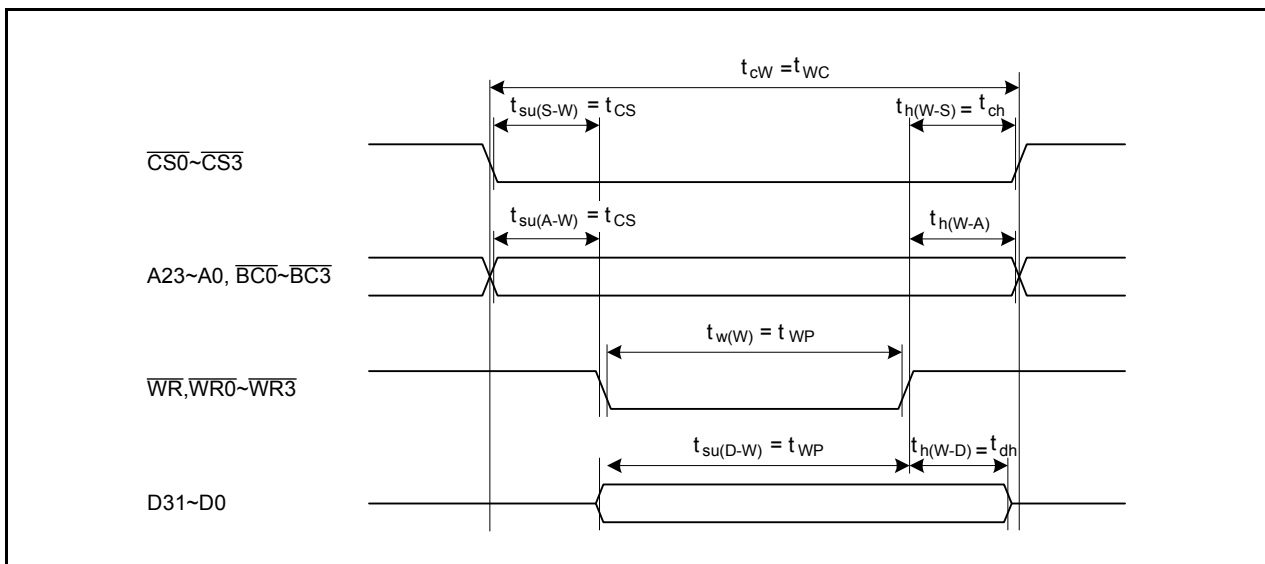


図 4.6 R32C/100 シリーズと外部デバイスのライトバスタイミング比較図

【ライトサイクル時間の算出】

ライトサイクル時間は、以下の関係式が成立するように $t_{su}(A-W)$ 、 $t_w(W)$ を調整します。

$$t_{CW} \leq t_{su}(A-W) + t_w(W) + t_h(W-A)$$

$t_w(W)$ は図 4.6 から、 t_{WP} 以上となるように時間を調整します。表 4.1 から、 t_{WP} は 45ns ですので、 $t_w(W)$ は 45ns 以上の時間を確保します。表 4.5 より $t_w(W)$ の最適値は 60ns になります。

表 4.5 MPY1~MPY0 ビット、EWW1~EWW0 ビットの設定値と $T_w(W)$ ($t_w(W)$) の関係

EWW1~EWW0 ビットの設定値		MPY1~MPY0 ビットの設定値			
		00b	01b	10b	11b
		mpy = 1	mpy = 2	mpy = 3	mpy = 4
00b	ww = 1	0.5 (注1)	1.5 (20ns)	2.5 (40ns)	3.5 (60ns)
01b	ww = 2	1.5 (20ns)	3.5 (60ns)	5.5 (100ns)	7.5 (140ns)
10b	ww = 3	2.5 (40ns)	5.5 (100ns)	8.5 (160ns)	11.5 (220ns)
11b	ww = 4	3.5 (60ns)	7.5 (140ns)	11.5 (220ns)	15.5 (300ns)
計算式		$T_w(W) = ww \times mpy - 0.5$			

注1. 設定しないでください。

注2. 表の網掛け部分は条件を満たしていない項目です。

注3. 単位はサイクルです。

算出した $t_w(W)$ の値を前述の式に当てはめると、

$$70ns \leq t_{su}(A-W) + 60ns + t_h(W-A)$$

となります。

$t_h(W-A)$ はユーザズマニュアルより、

$$1.5 \times t_c(\text{BASE}) - 15 = 15ns$$

ですので、前述の式に当てはめると、

$$70ns \leq t_{su}(A-W) + 60ns + 15ns$$

となり、 $t_{su}(A-W)$ は -5ns になります。算出した値がマイナスの場合は 0ns 以上の時間を確保します。表 4.6 より、 $t_{su}(A-W)$ の最適値は 5ns になります。

表 4.6 MPY1~MPY0 ビット、ESUW1~ESUW0 ビットの設定値と $T_{su}(A-W)$ ($t_{su}(A-W)$) の関係

ESUW1~ESUW0 ビットの設定値		MPY1~MPY0 ビットの設定値			
		00b	01b	10b	11b
		mpy = 1	mpy = 2	mpy = 3	mpy = 4
00b	suw = 0	1 (5ns)	1 (5ns)	1 (5ns)	1 (5ns)
01b	suw = 1	2 (35ns)	3 (45ns)	4 (65ns)	5 (85ns)
10b	suw = 2	3 (45ns)	5 (85ns)	7 (125ns)	9 (165ns)
11b	suw = 3	4 (65ns)	7 (125ns)	10 (185ns)	13 (245ns)
計算式		$T_{su}(A-W) = suw \times mpy + 1$			

注1. 単位はサイクルです。

tw(W)とtsu(A-W)の時間に該当するmpy、suw、wwの設定値を表 4.5、表 4.6から取得します。

表 4.7 mpy、sur、wr設定値

mpy	suw	ww
1	0	4
2	0	2
3	0	該当する値はなし
4	0	1

4.3 EBC0~EBC3の設定値

表 4.4、表 4.7から、クロック条件および外部デバイス条件を満たす最適な設定値を表 4.8に示します。EBC0~EBC3レジスタの設定値は“xx01 1100 00x1 1110b”になります。

表 4.8 EBC0~EBC3レジスタ最適値

項目	設定値
mpy	1
sur	2
wr	4
suw	0
ww	4

5. ハードウェア説明

5.1 使用端子一覧

表 5.1に使用端子と機能を示します。

表 5.1 使用端子と機能

端子名	入出力	内容
P2_1/A1~P2_7/A7	出力	外部デバイスへのアドレス出力
P3_0/A8~P3_7/A15		
P4_0/A16~P4_7/A23		
P0_0/D0~P0_7/D7	入出力	外部デバイスとのデータ入出力
P1_0/D8~P1_7/D15		
P11_0/CS0	出力	外部デバイスへのチップセレクト信号出力
P5_0/WR0/WR	出力	外部デバイスへのライト信号出力
P5_2/RD	出力	外部デバイスへのリード信号出力
P6_0	出力	割り込み要求確認用ポート (外部デバイスで動作させるプログラムで使用)

6. ソフトウェア説明

6.1 動作概要

外部デバイスに書かれたプログラムに分岐し、実行します。外部デバイス上にはあらかじめタイマA0をタイマモードで動作させるプログラムが書かれているものとします。

外部バスの動作条件を以下に示します。

- ・セパレートバス
- ・16ビットバス幅
- ・チップセレクト領域の設定
- ・バスタイミングの設定
- ・メモリ拡張モード

図 6.1にサンプルコードの動作イメージを示します。

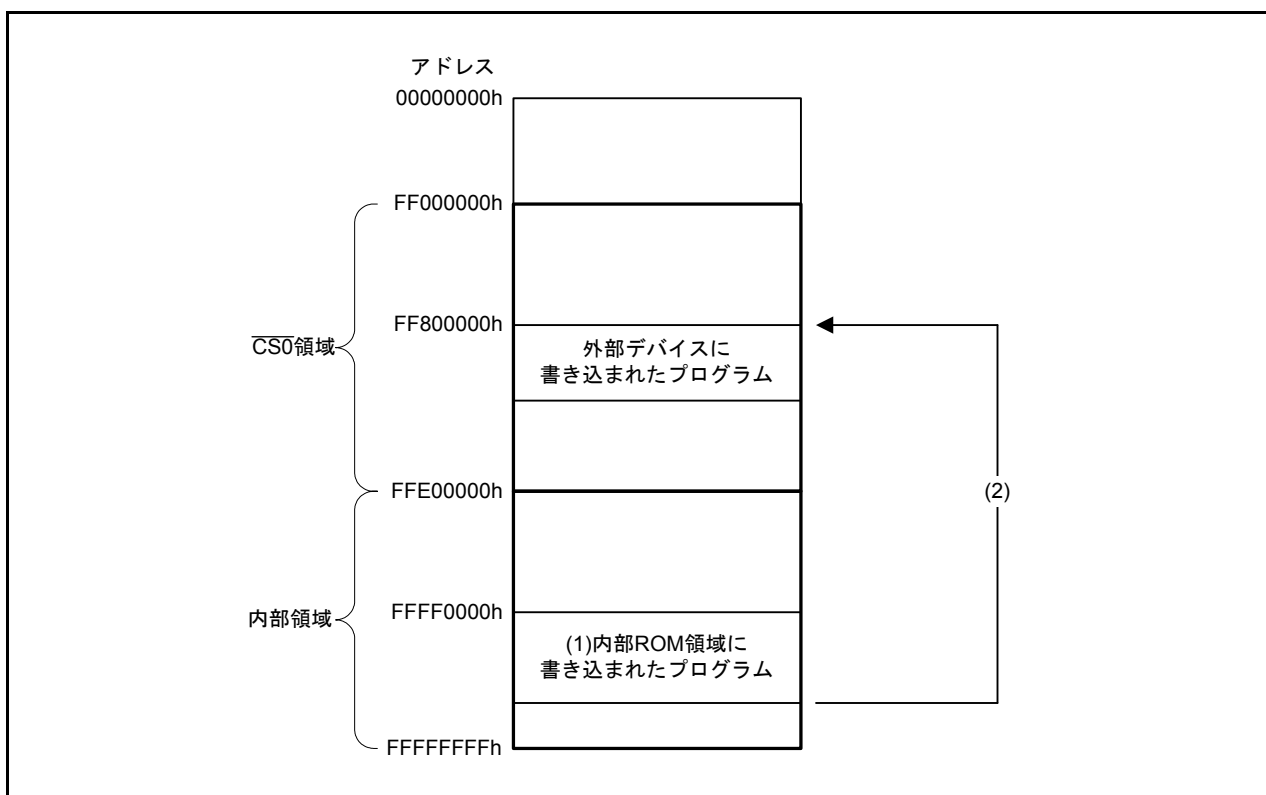


図 6.1 サンプルコードの動作イメージ

6.2 定数一覧

表 6.1にサンプルコードで使用する定数を示します。

表 6.1 サンプルコードで使用する定数

定数名	設定値	内容
DEF_CB01	C0h	CS0領域の先頭アドレス (FF000000h)のA25~A18の値を設定
DEF_CB12	80h	CS1領域の先頭アドレス (FE000000h)のA25~A18の値を設定
DEF_CB23	40h	CS2領域の先頭アドレス (01000000h)のA25~A18の値を設定

6.3 フローチャート

サンプルコードのフローチャートを示します。なお、フローチャート中の番号はソースコードの番号に対応しています。

6.3.1 メイン処理

図 6.2にメイン処理のフローチャートを示します。

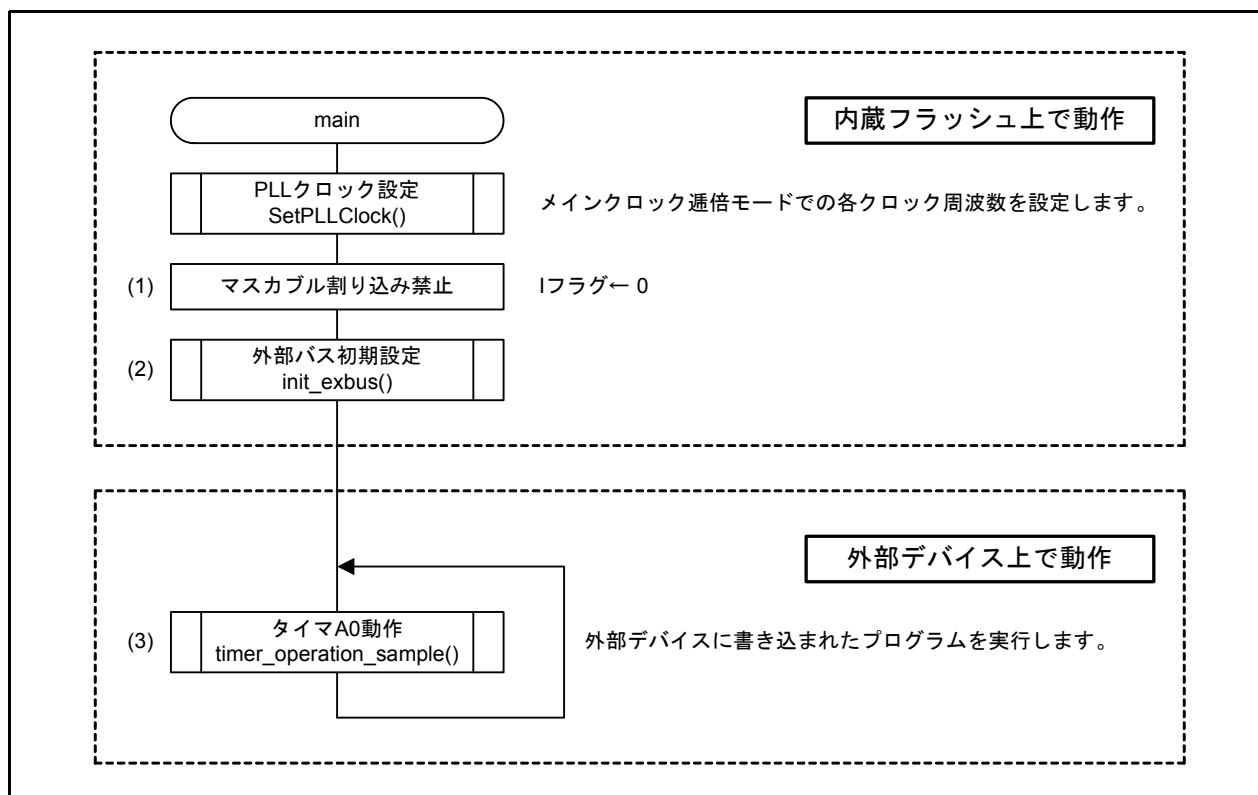


図 6.2 メイン処理

6.3.2 外部バス初期設定

図 6.3 に外部バスの初期設定手順を示します。

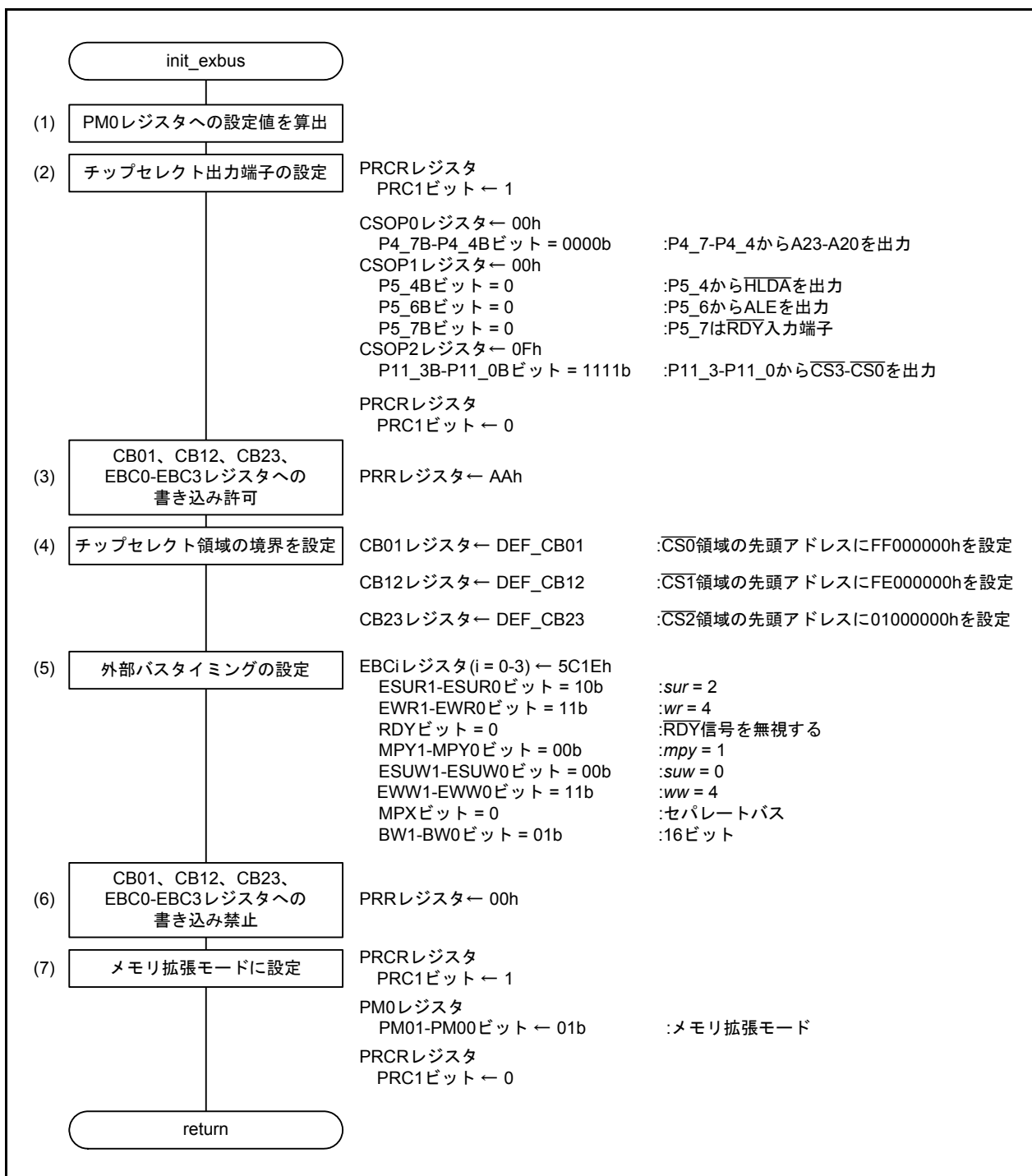


図 6.3 外部バスの初期設定手順

7. サンプルコード

サンプルコードは、ルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。

8. 参考ドキュメント

R32C/116 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10

R32C/117 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10

R32C/118 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10

(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース

(最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

Cコンパイラマニュアル

R32C/100 シリーズ用 Cコンパイラパッケージ Cコンパイラユーザーズマニュアル Rev.2.00

(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先

<http://japan.renesas.com/inquiry>

改訂記録	R32C/100シリーズ 外部バスの使用例
------	--------------------------

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2011.03.31	-	初版発行
1.01	2011.11.30	6	図4.1 追加「tcR : リードサイクル時間」、誤記修正「リード後アドレスセットアップ時間」→「リード後アドレスホールド時間」
		9	図4.4 誤記修正 th(W-A) : 「ライト後チップセレクトホールド時間」 →「ライト後アドレスホールド時間」 th(W-D) : 「ライト後データセットアップ時間」 →「ライト後データホールド時間」

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本文を参照してください。なお、本マニュアルの本文と異なる記載がある場合は、本文の記載が優先するものとします。

1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部 ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事情報の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社その総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



ルネサス エレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2（日本ビル）

(03)5201-5307

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問合せ窓口： <http://japan.renesas.com/inquiry>